PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2002-203683

(43) Date of publication of application: 19.07.2002

(51)Int.Cl.

H05B 33/14 C09K 11/06 H05B 33/22

(21)Application number : 2001-330212

(22)Date of filing: 29.10.2001

(71)Applicant : TOYOTA CENTRAL RES & DEV LAB INC

(72)Inventor: IKAI MASAMICHI

TAKEUCHI HISATO TOKITO SEIJI TAGA YASUNORI

(30)Priority

Priority number: 2000330356 Priority date

Priority date: 30.10.2000 Priorit

Priority country: JP

(54) ORGANIC ELECTROLUMINESCENT ELEMENT

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide an organic electroluminescent element that has a high luminous efficiency and high heat resistance.

SOLUTION: A hole transport layer is formed on a positive electrode and phosphorescence emission molecules such as Ir(ppy) 3 are doped on this hole transport layer and a luminous layer is made. An electron transport layer is formed on this luminous layer and a negative electrode is formed on top of it. The host material that constitutes the hole transport layer is a compound having a basic structure as expressed in the formula. Under this structure, the movement of energy to the phosphorescence emission molecules are easy, and as the glass transition temperature is 100° C or more, and organic electroluminescent element having a high luminous efficiency and high heat resistance can be obtained. Further, if a material having the following structure that has an icnization potential of 0.1 eV or more than the hole transport layer is used for the electron transport layer, the luminous efficiency can be further improved. In the formula, R1 and R2 and R3 and R4 and R2 and R3 can wind a ring. Or at least one of R1, R4 and R5 is

R.とR.及びR,とR4、R2世界。は現を奪いても良い。又はR、R、R。の少なくとも一つは歪成又は方管環であり、対記少なくとも一つの電流又は方管理を介して、少なくとももう一つの号格に定述したは合格である。又はR1、R4、R4の少なくとも一つは歪張又は方管環であり、前記少なくとも一つの空無又は方管環であり、前記少なくともも一つの空無又は方管環になれた化合物を介して、よくなくとももう一つの骨格に連続した化合物である。

nitrogen or an aromatic ring, and it is a compound linked with at least another structure through at least the one of the nitrogen or aromatic ring. Or at least one of R1, R4 and R5 is nitorogen or an aromatic ring, and it is a compound linked with at least another structure through the one of nitrogen or aromatic ring and through an alicyclic compound.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

mination] 27.01.2004

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]



Ocaloning 1710

[Patent number]

[Date of registration]

- [Number of appeal against examiner's decision of rejection]
 - [Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]
- . [Date of extinction of right]

CORRECTION

[Date of Correction] 09.06.2005

[Inventor]

[PAJ ORIGINAL] IGAI MASAMICHI

[CORRECTED] IKAI MASAMICHI

(19) 日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2002-203683 (P2002-203683A)

(43)公開日 平成14年7月19日(2002.7.19)

(51) Int.Cl. ⁷	識別記号	FI	デーマコート*(参考)
H05B 33/14		H05B 33/14	B 3K007
C09K 11/06	630	C09K 11/06	630
	690		690
H 0 5 B 33/22		H05B 33/22	В
		D	
		審査請求 未請	情求 請求項の数17 OL (全 30 頁)
(21) 出願番号	特顧2001-330212(P2001-330212)	(71)出蹟人 000	003609
		株式	《会社豊田中央研究所
(22)出顧日	平成13年10月29日(2001.10.29)	愛矢	0県愛知郡長久手町大字長湫字横道41番
		地位	01
(31)優先権主張番号	→ 特顧2000-330356 (P2000-330356)	(72)発明者 猪魚	河 正道
(32)優先日	平成12年10月30日(2000.10.30)	愛知	印原愛知郡長久手町大字長新字機道41番
(33)優先權主張国	日本(JP)	地位	01 株式会社豊田中央研究所内
		(72)発明者 竹口	为 久人
		爱统	印果愛知郡長久手町大字長湫字横道41番
		地位	の1 株式会社豊田中央研究所内
		(74)代理人 100	0075258
		升列	理士 吉田 研二 (外2名)
			最終頁に続く

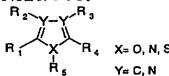
(54) 【発明の名称】 有機電界発光素子

(57)【要約】 (修正有)

【課題】 発光効率が高くかつ耐熱性の高い有機電界発 光素子を提供する。

【解決手段】 陽極の上にホール輸送層を形成し、このホール輸送層に Ir (ppy),等の燐光発光分子をドープして発光層とした。この発光層の上に電子輸送層を形成しその上に陰極を形成した。ホール輸送層を構成するホスト材料は、下記基本構造を有する化合物である。*

* これによれば、燐光発光分子へのエネルギー移動が容易でありかつガラス転移温度が100℃以上であるので、発光効率が高くかつ耐熱性の高い有機電界発光素子を得ることができる。さらに、下記構造を有する化合物でホール輸送層よりイオン化ポテンシャルが0.1eV以上大きい材料を電子輸送層に用いれば、さらに発光効率を向上できる。



* R₁とR₂及びR₃とR₄、R₂とR₅は環を巻いても良い。又はR₁、 R₄、R₅の少なくとも一つは窒素又は芳香環であり、前記少なく とも一つの窒素又は芳香環を介して、少なくとももう一つの骨格 に連結した化合物である。又はR₁、R₄、R₅の少なくとも一つは 窒素又は芳香環であり、前記少なくとも一つの窒素又は芳香環 を介し、かつ脂環式化合物を介して、すくなくとももう一つの骨格 に連結した化合物である。

【特許請求の範囲】

【請求項1】 複数の有機層を含むリン光発光の有機電 界発光素子であって、前記有機層の少なくとも1つを構* *成する有機材料が以下の構造を有し、 【化1】

X= 0, N, S

R、とR。及びR。とR、、R。とR。は環を巻いても良い。又はRi、 R。、R。の少なくとも一つは窒素又は芳香環であり、前記少なく とも一つの窒素又は芳香環を介して、少なくとももう一つの骨格 に連結した化合物である。又はR₁、R₄、R₆の少なくとも一つは 窒素又は芳香環であり、前記少なくとも一つの窒素又は芳香環 を介し、かつ脂環式化合物を介して、すくなくとももう一つの骨格 に連結した化合物である。

Y= C, N

そのガラス転移温度が100℃以上であることを特徴と する有機電界発光素子。

【請求項2】 請求項1記載の有機電界発光素子におい て、前記有機層にはホール輸送層と電子輸送層とが含ま れ、前記ホール輸送層または前記電子輸送層のいずれか に燐光発光分子がドープされた層を発光層とすることを 20 を含むことを特徴とする有機電界発光素子。 特徴とする有機電界発光素子。

【請求項3】 請求項2記載の有機電界発光素子におい

て、前記ホール輸送層を構成するホスト材料がカルバゾ ール系化合物であることを特徴とする有機電界発光素 子。

【請求項4】 請求項3記載の有機電界発光素子におい て、前記カルバゾール系化合物は、以下の構造の化合物 【化2】

【請求項5】 請求項2記載の有機電界発光素子におい 40 て、前記ホール輸送層として芳香族3級アミン単位を2個以上含む有機化合物が使用され、前記電子輸送層としてイミダゾール単位を2個以上含む有機化合物が使用され、前記ホール輸送層に燐光発光分子をドーブして発光層としたことを特徴とする有機電界発光素子。

【請求項6】 請求項5記載の有機電界発光素子において、前記ホール輸送層の陽極側に前記燐光発光分子がドープされていない部分が存在することを特徴とする有機電界発光素子。

【請求項7】 請求項6記載の有機電界発光素子におい 50 て、前記トリアゾール系化合物は、以下の構造の化合物

0 て、前記ホール輸送層の燐光発光分子がドーブされていない部分の厚さが陽極側から少なくとも10nmあり、ドーブ層が前記電子輸送層との界面から50nm以下の厚みであることを特徴とする有機電界発光素子。

【請求項8】 請求項2記載の有機電界発光素子において、前記電子輸送層を構成するホスト材料が、トリアゾール系化合物、イミダゾール系化合物、オキサジアゾール系化合物のうちのいずれかであることを特徴とする有機電界発光素子。

【請求項9】 請求項8記載の有機電界発光素子において、前記トリアゾール系化合物は、以下の構造の化合物

を含むことを特徴とする有機電界発光素子。

RのHはFでも良い

【化4】

【請求項10】 請求項8記載の有機電界発光素子において、前記イミダゾール系化合物は、以下の構造の化合

物を含むことを特徴とする有機電界発光素子。 【化5】

【請求項11】 請求項8記載の有機電界発光素子において、前記オキサジアゾール系化合物は、以下の構造の

化合物を含むことを特徴とする有機電界発光素子。 【化6】

【請求項12】 請求項2記載の有機電界発光素子において、前記ホール輸送層として芳香族3級アミン単位を2個以上含む有機化合物が使用され、前記電子輸送層としてイミダゾール単位を2個以上含む有機化合物が使用され、前記電子輸送層に燐光発光分子をドープして発光層としたことを特徴とする有機電界発光素子。

【請求項13】 請求項2から請求項12のいずれか一項記載の有機電界発光素子において、前記ホスト材料の発光スペクトルとゲスト材料である前記燐光発光分子の吸収スペクトルとに重なりが存在することを特徴とする有機電界発光素子。

【請求項14】 請求項2から請求項12のいずれか一 項記載の有機電界発光素子において、前記ホスト材料自 体も燐光を発し、前記ホスト材料の燐光スペクトルとゲ 50

スト材料である前記燐光発光分子の燐光スペクトルとに 重なりが存在することを特徴とする有機電界発光素子。 【請求項15】 請求項2から請求項12のいずれか一

(間水頃15) 間水頃2から間水頃12のいりれか一 40 項記載の有機電界発光素子において、前記ホスト材料の 蛍光スペクトルとゲスト材料である前記燐光発光分子の 吸収スペクトルとに重なりが存在することを特徴とする 有機電界発光素子。

【請求項16】 請求項2から請求項15のいずれか一項記載の有機電界発光素子において、前記発光層と金属電極との間に、バンドギャップが前記発光層より大きく、かつイオン化ポテンシャルが前記発光層のイオン化ポテンシャルより0.1 e V以上大きい電子輸送性化合物層が挿入されたことを特徴とする有機電界発光素子。 【請求項17】 請求項16記載の有機電界発光素子に 13

おいて、前記電子輸送性化合物層は、電子輸送性のフル オロベンゼン系有機化合物で構成されていることを特徴 とする有機電界発光素子。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は有機電界発光素子、 特に燐光発光を使用する有機電界発光素子の改良に関す る。

[0002]

【従来の技術】有機電界発光素子は、次世代平面ディス 10 プレイとして注目されており、この有機電界発光索子を 用いることにより、例えば直流低電圧駆動、広視野角、 自発光などの特徴を有するフルカラー高解像度ディスプ レイの実現が可能となる。そのためには、有機電界発光 素子の発光効率をさらに向上させる必要がある。

【0003】従来の有機電界発光素子の発光は、主に蛍 光を利用したものであった。すなわち、両電極から電子 及びホールを注入すると、それらが対電極に向かい、発 光層においてある割合で再結合して励起子を生成し、そ の励起子の励起状態が基底状態に戻るときに発光が生じ る。この励起状態には、電子スピンの向きが反平行であ る一重項励起状態と、電子スピンの向きが平行となる三 重項励起状態とがあるが、上述した蛍光は、一重項励起 状態のみが関与する発光形態である。単純な量子力学的 推論から、一重項励起状態と三重項励起状態の生成比率 は1:3であるので、蛍光を利用した有機電界発光素子 の場合には内部量子効率の最大値は25%となる。つま り、励起状態の75%は発光に使用されないことにな る。さらに、有機電界発光素子に用いられる有機材料の 屈折率 (n) は約1. $6\sim 1$. 7 であり、また、外部へ 30 N' -ジカルバゾールーピフェニル(4. 4' - N. の取り出し効率(カ・・・・)は、古典光学における反射と 屈折の法則から $\eta_{**} = 1/(2 n^2) = 0.2 r$ あり、 したがって高々20%程度である。そのため、蛍光を利 用した有機電界発光素子においては、その外部量子効率 は25%×20%となり、最大5%程度と見積もられ

【0004】このため、外部量子効率をさらに向上させ るためには、励起状態のうち75%を占める三重項励起 状態からの発光すなわち燐光も利用する必要がある。と 向上させることができるからである。このために、例え ばM. A. Baldo, S. Lamansky, P. E. Burrows, M. E. Thompson, S. R. Forrest, Appl. Phys. Lett.

14

75 (1999) 4., "Very high-eff iciency green organic lig ht-emitting devices based on electrophosphorescenc e"等にも記載されているように、イリジウム錯体をド ーパントとして用いることによって燐光を使用した有機 電界発光素子が提案されている。このような有機電界発 光素子の構成によれば、外部量子効率が5%を超える結 果が得られている。

【0005】図1には、上記イリジウム錯体をドーパン トとして使用した有機電界発光素子の発光原理の説明図 が示される。図1において、イリジウム錯体がドープさ れたホスト材料が電子とホールとの再結合によりまず励 起状態となる。との場合には、上述したように一重項励 起状態が25%であり三重項励起状態が75%となって いる。次にとのホスト材料の励起状態が、ドーパントで あるイリジウム錯体に移動し、それぞれ一重項励起状態 及び三重項励起状態が生じる。イリジウム錯体の一重項 励起状態は、さらに三重項励起状態に移動し、最終的に 20 全て三重項励起状態からの燐光発光となる。これによっ て、発生した励起状態のエネルギー全てを発光エネルギ ーとして使用することができる。

[0006]

【発明が解決しようとする課題】しかし、上記従来の燐 光を利用した有機電界発光素子においては、発光効率の 理論限界値である20%からは未だに隔たりがあり、さ らに発光効率を向上させる必要がある。

【0007】また、上述したイリジウム錯体をドープす るためのホスト材料としては、例えば4, 4'-N, N'-dicarbazole-biphenyl, C BP) 等が使用されているが、この材料は耐熱性が低い ので、自動車等の高温となる場所での使用ができないと いう問題があった。

【0008】本発明は、上記従来の課題に鑑みなされた ものであり、その目的は、発光効率が高くかつ耐熱性の 高い有機電界発光素子を提供することにある。

[0009]

【課題を解決するための手段】上記目的を達成するため の利用が可能となれば、外部量子効率を最大20%まで 40 に、本発明は、複数の有機層を含む有機電界発光素子で あって、前記有機層の少なくとも1つを構成する有機材 料が以下の構造を有し、

[化7]

15
$$R_{2} Y - Y R_{3}$$

$$R_{1} X R_{4} X = 0, N, S$$

$$R_{5} Y = C, N$$

* R₁とR₂及びR₃とR₄、R₂とR₃は環を巻いても良い。又はR₁、R₄、R₅の少なくとも一つは窒素又は芳香環であり、前記少なくとも一つの窒素又は芳香環を介して、少なくとももう一つの骨格に連結した化合物である。又はR₁、R₄、R₂の少なくとも一つは窒素又は芳香環であり、前記少なくとも一つの窒素又は芳香環を介し、かつ脂環式化合物を介して、すくなくとももう一つの骨格に連結した化合物である。

そのガラス転移温度が100℃以上であることを特徴とする。

【0010】また、上記有機電界発光素子において、有機層にはホール輸送層と電子輸送層とが含まれ、ホール輸送層または電子輸送層のいずれかに燐光発光分子がドープされた層を発光層とすることを特徴とする。

【0011】また、上記有機電界発光素子において、ホ

ール輸送層を構成するホスト材料がカルバゾール系化合 物であることを特徴とする。

【0012】また、上記有機電界発光素子において、カルバゾール系化合物は、以下の構造の化合物を含むことを特徴とする。

[0013]

【化8】

また、上記有機電界発光素子において、ホール輸送層として芳香族3級アミン単位を2個以上含む有機化合物が使用され、電子輸送層としてイミダゾール単位を2個以上含む有機化合物が使用され、ホール輸送層に燐光発光分子をドーブして発光層としたことを特徴とする。

【0014】上記各構成によれば、有機材料のガラス転移温度が100℃以上であるので、有機電界発光素子の耐熱性を向上させることができる。

【0015】また、上記有機電界発光素子において、ホール輸送層の陽極側に燐光発光分子がドープされていない部分が存在することを特徴とする。

40 【0016】また、上記有機電界発光素子において、ホール輸送層の燐光発光分子がドープされていない部分の厚さが陽極側から少なくとも10nmあり、ドープ層が電子輸送層との界面から50nm以下の厚みであることを特徴とする。

【0017】上記構成によれば、発光層で生成された励起子が陽極へ吸収されることを防止でき、また、電子輸送層のイオン化ポテンシャルが大きいのでホールがブロックされ、有機電界発光素子の発光効率を向上できる。 【0018】また、上記有機電界発光素子において、電

50 子輸送層を構成するホスト材料が、トリアゾール系化合

* を特徴とする。 【 0 0 2 0 】 【 化 9 】

のうちのいずれかであることを特徴とする。 【0019】また、上記有機電界発光素子において、ト リアゾール系化合物は、以下の構造の化合物を含むこと*

RのHはFでも良い

【化10】

また、上記有機電界発光素子において、イミダゾール系 [0021] 化合物は、以下の構造の化合物を含むことを特徴とす 【化11】 る。

また、上記有機電界発光素子において、オキサジアゾール系化合物は、以下の構造の化合物を含むことを特徴とする。

[0022]

【化12】

また、上記有機電界発光素子において、ホール輸送層として芳香族3級アミン単位を2個以上含む有機化合物が使用され、電子輸送層としてイミダゾール単位を2個以上含む有機化合物が使用され、電子輸送層に燐光発光分子をドーブして発光層としたことを特徴とする。

【0023】上記各構成によれば、有機材料のガラス転移温度が100℃以上であるので、有機電界発光素子の耐熱性を向上させることができる。

【0024】また、上記有機電界発光素子において、ホスト材料の発光スペクトルとゲスト材料である燐光発光分子の吸収スペクトルとに重なりが存在することを特徴とする。

【0025】また、上記有機電界発光素子において、ホ 大きく、かつイオン化ポテンシャルが発光層のイオン化スト材料自体も燐光を発し、ホスト材料の燐光スペクト 50 ポテンシャルより0.1eV以上大きい電子輸送性化合

ルとゲスト材料である<u>燐光発光分子</u>の<u>燐光</u>スペクトルと に重なりが存在することを特徴とする。

【0026】また、上記有機電界発光素子において、ホ 40 スト材料の蛍光スペクトルとゲスト材料である燐光発光 分子の吸収スペクトルとに重なりが存在することを特徴 とする。

【0027】上記各構成によれば、スペクトルの重なりにより、ホスト材料からゲスト材料への励起状態エネルギーの移動が容易となり、有機電界発光素子の発光効率を向上できる。

【0028】また、上記有機電界発光素子において、発 光層と金属電極との間に、バンドギャップが発光層より 大きく、かつイオン化ポテンシャルが発光層のイオン化 ポテンシャルより0 1 a V以上大きい電子輸送性化会

28

物層が挿入されたことを特徴とする。

【0029】また、上記有機電界発光索子において、電 子輸送性化合物層は、電子輸送性のフルオロベンゼン系 有機化合物で構成されていることを特徴とする。

27

【0030】上記構成によれば、発光層から金属電極へ 励起子が吸収されることを防止でき、かつ発光層に注入 されたホールが電子輸送層に移動することを防止でき る。

[0031]

【発明の実施の形態】以下、本発明の実施の形態(以下 10 示す基本骨格を有する有機材料がホスト材料として使用 実施形態という)を、図面に従って説明する。

【0032】実施形態1.図2には、本発明に係る有機 電界発光素子の構成の断面図が示される。図2におい * * て、 ITO等により構成される陽極10の上に、ホール 輸送層12が形成され、ホール輸送層12の上には電子 輸送層14が形成され、さらに電子輸送層14の上に陰 極16が形成されている。とのホール輸送層12及び電 子輸送層14は有機化合物で構成されており、有機電界 発光素子には複数の有機層が含まれている。

【0033】本実施形態においては、ホール輸送層12 に燐光発光分子をドープし、発光層としている。発光層 となるホール輸送層12を構成する有機層には、以下に される。

[0034] 【化13】

R,とR2及びR3とR4、R2とR3は環を巻いても良い。又はR1、 R、、R。の少なくとも一つは窒素又は芳香環であり、前記少なく とも一つの窒素又は芳香環を介して、少なくとももう一つの骨格 に連結した化合物である。又はR、、R。、R。の少なくとも一つは 窒素又は芳香環であり、前記少なくとも一つの窒素又は芳香環 を介し、かつ脂環式化合物を介して、すくなくとももう一つの骨格 に連結した化合物である。

上記ホスト材料は、そのガラス転移温度(Tg)が10 0℃以上であり、車載用途等の髙温環境での使用にも耐 えられるものである。すなわち、前述したCBP等の材 料では、60℃以上に加熱すると有機薄膜の凝集が起と り、薄膜表面が著しく粗くなってしまう。これに対し て、上記基本骨格(1)を有する化合物では、上述の通 30 【0036】 りガラス転移温度が100°C以上であるので、薄膜化し た場合にも100℃以下では凝集せず、膜の平滑性が維

持される。したがって、車載用途等の高温環境での使用 にも耐えることができる。

【0035】とのようなホスト材料としては、例えばカ ルバゾール系化合物が考えられる。カルバゾール系化合 物の例としては以下のようなものがある。

【化14】

上記化合物のうち(a1)が4、4′、4″ートリス (カルバソリル)ートリフェニルアミン(TCTA)で あり、芳香族三級アミン単位が2個以上含まれた有機化 合物である。との化合物は、シンテック(Synte c)社から市販されている。

【0037】また、(a3)が2、2-ビス(4-(4'-(N-カルバゾリル)フェニル(またはピフェニルまたはトリフェニル))アダマンタンである。この物質をホスト材料として使用することにより、有機電界発光素子の高効率発光及び耐熱性の向上を図ることができる。

40 【0038】さらに、(a4)が1,3,5-トリス (4-(N-カルバゾリル)フェニル)ベンゼン(TC PB)である。この化合物は、例えば特開平7-90256号公報に合成方法が開示されている。このTCPBをホスト材料として使用することにより、有機電界発光素子の耐熱性の向上及び長寿命化を図ることができる。【0039】上述したホール輸送層12にドープする燐光発光分子としては、例えばトリス(2-フェニルピリジン)イリジウム(tris(2-phenylpyridine)iridium(III), Ir(pp 50 y),)等が考えられる。ただし、燐光発光を生じさせ

32

る分子であれば特に上記 1 r (ppy), に限られるも のではない。このIr(ppy),も市販品であり、容 易に入手できる。

【0040】さらに、電子輸送層14としては、例えば イミダゾール単位を2個以上含む有機化合物を使用する ことができる。また、陰極16としては、例えばMg-Ag合金、Al-Li合金、LiF/Al、Al等の金 属電極を使用することができる。なお、アルカリフッ化 物、アルカリ酸化物あるいは金属をドーブした有機層を 極10とホール輸送層12との間にはCuPcやスター バーストアミン、バナジウム酸化物等をホール注入層と して挿入することも好適である。

【0041】図3には、図2に示された本実施形態に係 る有機電界発光素子のエネルギー準位図が示される。図 3において、陽極10(ITO電極)と陰極16(金属 電極)との間に電圧を印加すると、イミダゾール系化合 物で構成された電子輸送層14から芳香族三极アミン系 化合物で構成されたホール輸送層12に電子が注入さ れ、ホール輸送層12中の燐光発光分子がドープされた 20 領域で前述した図1に示されたメカニズムにより燐光発 光が生じる。

【0042】図3に示されるように、燐光発光分子はホ ール輸送層12の一部にドープされている。すなわち、 ホール輸送層12の陽極10側に燐光発光分子がドーブ されていない部分が少なくとも10nm存在する。上記 ドーブ層は、ホール輸送層12と電子輸送層14との界 面から50nm以下、より好ましくは30nm以下の厚 みとなっている。とれは、三重項励起子の移動距離に限 界があり、これよりドープ層を厚くしても発光効率が向 30 上しないためである。

【0043】図4には、本実施形態に係る有機電界発光 素子の変形例が示される。図4において、発光層である 第1のホール輸送層12と陽極10との間に第2のホー ル輸送層18が設けられている。この第2のホール輸送 層18としては、例えば4,4°-ビス[N-(1-ナ フチル)-N-フェニル-アミノ] ピフェニル (4, 4' - bis[N-(1-naphthyl)-N-p]henyl-amino] biphenyl, α -NP D) が使用される。このような構成とすることにより、 α-NPDのITO基板上における密着性が非常に良く なり、さらにITOの仕事関数(5.0eV)と α -N PDのHOMOレベル(5.4eV)が非常に近いた め、ホール注入が比較的容易にできる。また、ホール移 動度が大きいため、ホールが効率良く発光層へ輸送さ れ、そとで電子と効率良く再結合し、励起子を生成する ことができる。

【0044】以上の理由から、ホール輸送層に芳香族3 級アミンに属するTPTE等の材料を用いてもよい。 【0045】図5には、図4に示された変形例のエネル 50 への励起状態の移動が容易に起こり、発光効率を向上で

ギー準位図が示される。図5において、陽極10(IT 〇電極)と陰極16 (金属電極) との間に電圧を印加す ると、イミダゾール系化合物で構成された電子輸送層 1 4から芳香族三級アミン系化合物で構成された第1のホ ール輸送層12に電子が注入され、また、第2のホール 輸送層18から第1のホール輸送層12にホールが注入 され、第1のホール輸送層12中の燐光発光分子により 前述した図1に示されたメカニズムにより燐光発光が生 じる。なお、本変形例においては、発光層である第1の 電子注入層として使用することも好適である。また、陽 10 ホール輸送層12の全体に燐光発光分子がドーブされて いてもよい。したがって、その際の第1のホール輸送層 12の厚さは、前述の図3におけるドープ層の厚さ程度 とすればよい。

> 【0046】以上に述べた図2から図5に示された本実 施形態の有機電界発光素子では、発光層であるホール輸 送層12と陰極16との間に電子輸送層14が形成され ているが、この電子輸送層を、イミダゾールあるいはフ ルオロベンゼン系の有機化合物(例えばCsoFsg)等 の、バンドギャップがホール輸送層12(発光層)より 大きく、かつイオン化ポテンシャルが発光層のイオン化 ポテンシャルより 0. 1 e V以上大きい材料で構成すれ ば、さらに発光効率を向上させることができる。これ は、図3及び図5に示されるように、電子輸送層14の バンドギャップを大きくすることにより、燐光発光分子 がドーブされたホール輸送層12における三重項励起状 態が陰極16に吸収されることを防止でき、また電子輸 送層のイオン化ポテンシャルを発光層のイオン化ポテン シャルより0.1eV以上大きくすることにより、ホー ル輸送層12に注入されたホールが電子輸送層14に流 れ込まないようにブロックすることができるからであ る。

【0047】さらに、ホール輸送層12を構成するホス ト材料は、それ自体燐光を発するものであってもよい。 その場合、ホスト材料の発光スペクトル(燐光スペクト ル)と、これにドープするゲスト材料である燐光発光分 子の燐光スペクトルとで、そのピークに重なりが存在す るとホスト材料の励起状態エネルギーがゲスト材料へ移 動しやすくなり、さらに発光効率を向上することができ る。特に、上記スペクトルの重なりが30%以上となる 40 ととが好適である。例えば上記基本骨格(1)を有する 有機材料をホスト材料とした場合には、その光学吸収端 から求めたエネルギーギャップは通常3.0 e V以上あ る。また、燐光発光分子としてir(ppy)」を使用 した場合には、その燐光スペクトルが510nmにメイ ンピーク、540nmにショルダーピークを有し、50 0~650nmの範囲に広がったスペクトルになる。と のため、上記基本骨格(1)を有する有機材料と Ir (ppy),との燐光スペクトルが広い範囲で重なり合 うことになる。これにより、ホスト材料からゲスト材料 きる。

【0048】なお、上記スペクトルのピークの重なり合 いは、ホスト材料の蛍光スペクトルとゲスト材料の燐光 スペクトル(または吸収スペクトル)との重なりであっ てもよい。スペクトルに重なりがあれば、励起状態の移 動が起こりやすいからである。との場合にも、上記スペ クトルの重なりが30%以上となることが好適である。 【0049】実施形態2. 図6には、本発明に係る有機 電界発光素子の実施形態2の構成の断面図が示される。 図6において、陽極10と陰極16とは図2に示された 10 の構造の化合物が含まれる。 実施形態1と同様の構成となっている。しかし、本実施 形態においては、実施形態1と異なり、電子輸送層14 に燐光発光分子がドープされ、この電子輸送層14が発*

33

*光層とされている。この場合燐光発光分子がドープされ た有機層である電子輸送層14を構成するホスト材料 は、実施形態1と同様に基本骨格(1)を有する電子輸 送性の化合物となっている。このホスト材料も、そのガ ラス転移温度(Tg)は100℃以上である。

【0050】とのような化合物の例として、例えばトリ アゾール系化合物、イミダゾール系化合物、オキサジア ゾール系化合物などがある。

【0051】上記トリアゾール系化合物としては、以下

[0052]

【化15】

RのHはFでも良い

がある。 【0054】 【0053】また、上記イミダゾール系化合物として 【化17】

は、以下の構造の化合物が含まれる。

いずれもイミダゾール単位を2個以上含んでいる。 【0055】また、上記オキサジアゾール系化合物とし ては、以下の構造の化合物が含まれる。

[0056] 【化18】

また、ホール輸送層12としては、実施形態1と同様に 芳香族三級アミン単位を2個以上含む有機化合物を使用 することができる。

【0057】図7には、図6に示された実施形態2のエ 40 ネルギー準位図が示される。陽極10と陰極16との間 に電圧を印加すると、芳香族三級アミンで構成されたホ ール輸送層12からホールが電子輸送層14に注入さ れ、ドーパントである燐光発光分子がドープされた領域 で前述した図1に示されるメカニズムにより燐光発光が 生じる。本実施形態においては、電子輸送層14の有機 層を構成するホスト材料としてイミダゾール系化合物が 使用されている。

【0058】図7の場合にも、図3の場合と同様、燐光 発光分子のドーブ層の厚さは50nm以下、より好まし 50 ップも、実施形態1と同様に第1の電子輸送層14より

くは30 n m以下とするのが好適である。

【0059】図8には、図6に示された本実施形態に係 る有機電界発光素子の変形例が示される。図8において は、発光層を構成する第1の電子輸送層14と陰極16 との間に第2の電子輸送層20が形成されている。との 変形例に対応するエネルギー準位図が図9に示される。 図9から分かるように、第2の電子輸送層20のイオン 化ポテンシャルは、発光層である第1の電子輸送層14 のイオン化ポテンシャルよりも0.1eV以上大きくな っており、実施形態1で説明したように、発光層である 第1の電子輸送層14に注入されたホールが第2の電子 輸送層20側に移動することをブロックしている。

【0060】また、第2の電子輸送層20のバンドギャ

41

も大きくなっており、第1の電子輸送層14で生成した 励起状態が陰極16である金属電極に吸収されることを 防止している。

【0061】上記第2の電子輸送層20の材料として は、実施形態1と同様に、イミダゾールあるいはフルオ ロベンゼン系の有機化合物等を使用することができる。 【0062】なお、本実施形態においても、発光層を横 成するホスト材料は、上記基本骨格(1)を有してお り、このフォトルミネッセンススペクトルは、ゲスト材 料である「r(ppy)」の吸収スペクトルと重なりが 存在している。このため、ホスト材料で生じた励起状態 エネルギーが容易に燐光発光分子に移動することがで き、高い発光効率を得ることができる。また、実施形態 1と同様に、ホスト材料の蛍光スペクトルとゲスト材料 である燐光発光分子の吸収スペクトルとに重なりが存在 するので、やはりホスト材料で生じた励起状態がゲスト 材料に移動しやすくなり、発光効率を向上させることが できる。この場合の燐光スペクトル同士あるいは蛍光ス ベクトルと燐光スペクトルとの重なりは30%以上とな るのが好適である。

【0063】以上に説明した各実施形態の具体例を実施例として説明する。

【0064】実施例1. ガラス基板上にITOの透明電極を150nm形成し、その上に真空度 3×10^{-7} トールの圧力で真空蒸着によりホール輸送層としての α -NPD層を40nm堆積した。との α -NPDの構造は以下に示すとおりである。

[0065]

【化19】

上記α-NPD層の上には、ホスト材料として上述した TCTA層を20nmの厚さで形成し、ととにドーパントとしてIr(ppy),を5.5wt%ドーブした。なお、Ir(ppy),の構造は以下の通りである。 【0066】

【化20】

さらに、ホールが発光層から電子輸送層 1 4 側に移動しないようにブロックする層 (ホールブロック層) とし

て、電子輸送性のフルオロベンゼン系の有機化合物、例 えば以下に示される構造を有するC。, F 4. (以下化合物 Cという)を20nm蒸着した。

42

[0067]

【化21】

さらにこの上に電子輸送層として以下に示される構造を 有するAlq,を30nm蒸着した。

[0068]

【化22】

20

30

最後にLiFを0.5nm、Alを150nm蒸着し、 金属電極を形成した。なお、本実施例は、図4に示され た実施形態1の変形例に対応するものである。

【0069】以上のようにして形成された素子を、高真空排気したチャンバーに入れ、チャンバー内を窒素置換した後、エポキシ樹脂を用いた封止ガラスの端部を透明電極の表面に接着し密封した。この有機電界発光素子に直流電圧を印加し、連続駆動させて発光効率を測定しれ。その結果、最大65.1cd/Aの発光効率を得た。この場合の輝度は716cd/m²であり、駆動電圧3.9 Vのときの角度分布補正後の外部量子効率は最大18.0%に達した。

【0070】また、ホールブロック層として、上記化合物Cの代わりに、やはり電子輸送性のフルオロベンゼン系の有機化合物である、以下に示される構造を有するC。F、(以下化合物Bという)を20nm蒸着した素子も作成した。

[0071]

50 【化23】

この化合物Bを使用した有機電界発光素子に直流電圧を 印加し、連続駆動させて発光効率を測定した。その結 果、最大73.0cd/Aの発光効率を得た。この場合 の輝度は401.3cd/m'であり、駆動電圧3.5 2 Vのときの角度分布補正後の外部量子効率は最大1 9. 2%に達した。

は、Y. Sakamoto, T. Suzuki, A. M iura, H. Fujikawa, S. Tokito, and Y. Taga, J. Am. Chem. Soc. 122, (2000) 1832 に合成方法が開示されて

【0073】以上に述べた実施例1の素子構造の断面図 が図10に示される。なお、図10においては、基板と してガラス基板が使用されているが、これに限られるも のではない。例えば、プラスチック、セラミックス等も 使用できる。

【0074】実施例2. ガラス基板上にITOの透明電 極を150nm形成し、3×10-1トールの真空度でα -NPD層を40nm真空蒸着により堆積した。この上 に、実施例1と同様にホスト材料としてのTCTAにド ーパントとしてIr(ppy),を5.5wt%ドープ した層を発光層として20nm蒸着した。さらに、この 発光層からホールが外に移動することをブロックするた めのホールブロック層として、以下の構造を有する2, 2', 2"-(1, 3, 5-フェニレン)トリス[1-フェニル-1H-ベンズイミダゾール], TPBI)層 40 を50nm蒸着した。なお、このTPBIは、特開平1 0-106749号公報に合成方法が開示されている。 [0075]

·【化24】

10 さらに、この上にLiFをO. 5 nm、Alを150 n m蒸着し金属電極を形成した。以上に示された本実施例 に係る素子の断面図が図11に示される。なお、図11 においては、基板としてガラス基板が使用されている が、これに限られるものではない。例えば、プラスチッ ク、セラミックス等も使用できる。

【0076】図11に示された本実施例に係る素子は、 実施例1と同様に図4に示された実施形態1の変形例に 対応したものである。

【0077】以上のようにして形成された素子を髙真空 【0072】なお、以上に述べた化合物B及び化合物C 20 排気したチャンバーに搬送し、チャンバー内を窒素置換 した後、エポキシ樹脂を用いて封止ガラスの端部を透明 電極の表面に接着し密封した。このように形成した有機 電界発光素子に直流電圧を印加し、連続駆動させて発光 効率、輝度、半減寿命等を測定した。その結果、最大6 1 c d/Aの発光効率を得た。また輝度が1350 c d /m²、駆動電圧4.7Vのときの角度分布補正後の外 部量子効率が最大で16.0%に到達した。

> 【0078】比較例1. ガラス基板上にITOの透明電 極を150nm形成し、その上にα-NPD層を、真空 30 度3×10⁻⁷トールで真空蒸着により40nm堆積して 正孔輸送層とした。その上に、ホスト材料としてCBP を使用し、ドーパントとしてIr(ppy)」をドープ した発光層を20nm蒸着した。との際のドーパント濃 度は7.5 w t %であった。さらに発光層の上部に、発 光層に注入されたホールが外部に移動しないようにホー ルブロック層として以下の構造を有するパソクプロイン (bathocuproine、BCP、市販品であ る)を10nm形成した。

[0079]

【化25】

とのBCP層の上に電子輸送層としてAlq,を40n m蒸着した。さらにその上に、LiFを0.5nm、A 1を150 n m蒸着して金属電極を形成した。以上のよ 50 うにして形成した本比較例の有機電界発光素子の断面図

が図12に示される。

【0080】上記のようにして形成した本比較例の有機 電界発光素子に直流電圧を印加し、連続駆動させて発光 効率を測定した。低電流密度領域において最大30.1 cd/Aの発光効率を得た。この場合の角度分布補正後 の外部量子効率は最大で8.3%であった。

【0081】以上に述べた実施例1及び比較例1に係る 素子の電流密度対外部量子効率が図13に、実施例2及 び比較例1に係る有機電界発光索子の電流密度対外部量 子効率が図14にそれぞれ示される。いずれの場合に も、本発明に係る実施例1、実施例2の素子が比較例の 素子に比べて大幅に外部量子効率が向上していることが 分かる。

【0082】実施例3.上述した実施例2で形成した有 機電界発光素子を恒温槽(オーブン)に入れ、室温から 10℃刻みで昇温させ、各温度で1時間維持した後、発 光効率を測定した。その結果、100℃においても、室 温時の50%以上の発光効率が維持された。

【0083】比較例2. 比較例1に示された有機電界発 光索子を恒温槽(オーブン)に入れ上記実施例3と同様 にして発光効率を測定した。その結果、80℃において すでに室温時の20%程度の発光効率まで低下した。

【0084】以上に示された実施例3及び比較例2の結 果が図15に示される。

【0085】実施例4.以上に述べた実施例2において は、ホールブロック層すなわち電子輸送層の材料として はイミダゾール系化合物であるTPBIを使用したが、 これをトリアゾール系の化合物としてもよい。これらの イミダゾール系化合物またはトリアゾール系化合物は、 HOMOレベルが深く、LUMOレベルが浅いので、電 子輸送層に利用すると、ホールや励起子を効率良くブロ ックできるからである。

【0086】実施例5.ガラス基板上にITOの透明電 極を150nm形成し、その上に真空度3×10-'トー ルでα-NPDを40nm真空蒸着して正孔輸送層を形 成した。さらにその上に、ホスト材料としてのTPBI に、ドーパントとしてIr(ppy),を7.5wt% の濃度でドープした層を20mm形成し、発光層とする とともに、さらにTPBI層を50nm堆積した。この 上に、LiFを0.5nm、Alを150nm蒸着し金 属電極を形成した。とのように形成した素子の断面が図 16に示される。との素子を髙真空排気したチャンバー へ搬送し、チャンバー内を窒素置換した後、エポキシ樹 脂を用いて封止ガラスの端部を透明電極の表面に接着し 密封した。図16に示された本実施例の有機電界発光素 子は、図6に示された実施形態2の有機電界発光素子に

【0087】上述のようにして形成した有機電界発光素 子に直流電圧を印加し、連続駆動させて発光効率を測定

であり、上述した比較例1と同等のレベルであったが、 **耐熱性が向上し、100℃以上でも高い発光効率を維持** することができた。

【0088】実施例6. ガラス基板上に、図17 (a)、(b)、(c)に示される組み合わせの有機薄 膜を蒸着し、それぞれの耐熱性を比較した。図17 (a) の薄膜は、ガラス基板上にITOを蒸着し、その 上にα-NPDを40nm蒸着したものである。また、 図17(b)の薄膜は、図17(a)と同様に、ガラス 10 基板上に I TOを蒸着し、その上にα-NPDを40n m蒸着した後、さらにその上に市販品であるCBPを2 Onm蒸着したものである。また、図17(c)の薄膜 は、図17(b)のCBPに代えてTCTAを20nm 蒸着したものである。

【0089】以上のように形成した各有機薄膜の温度を 室温(25℃)に維持した状態で、原子間力顕微鏡(タ ッピングモード) によりその表面のモルフォロジーを観 察した。その後、各有機薄膜をオーブンに入れ、54℃ または74℃の温度で1時間保持した後室温まで冷却し 20 て、再度原子間力顕微鏡によりその表面のモルフォロジ ーを観察した。

【0090】ITO上にα-NPDのみを蒸着した図1 7 (a) の場合には、有機薄膜の温度の上昇に伴い、表 面平均粗さが小さくなった。また、α-ΝΡDの上にC BPを蒸着した図17(b)の場合には、有機薄膜の温 度を上げると、60℃以上の温度で表面モルフォロジー が劇的に変化し、表面平均粗さが1桁以上大きくなっ た。この場合には、有機薄膜が凝集する様子が明確に観 察された。とれらの結果が、図18に示される。図18 では、横軸が有機薄膜の温度であり、縦軸が薄膜表面の 平均粗さである。また、黒塗り四角で図17(a)の結 果が、黒三角で図17(b)の結果がそれぞれ示されて いる。特に、図17(b)の場合に、上述したように6 0℃以上の温度で表面平均粗さが大きく変化していると とがわかる。

【0091】以上に対して、α-NPDの上にTCTA を蒸着した図17(c)の場合には、有機薄膜の温度を 75℃まで上げても表面平均粗さは全く変化せず、表面 モルフォロジーも初期の状態を維持していた。この結果 40 が図19に示される。

【0092】実施例7.ガラス基板上にITOの透明電 極を150nm形成し、その上に真空度5×10-1ト ール (6.65×10⁻¹Pa) $\sigma \alpha$ -NPDを40nm 真空蒸着により正孔輸送層を形成した。その上にホスト 材料として、前述した(a3)の物質のうち、2,2-**ビス(4 - (4' - (N - カルバゾリル)ビフェニル)** アダマンタン(AdBPCz、フェニル基の数が2個) を使用し、これにドーパントとしてIr(ppy),を7 wt%の濃度でドープした層を20nm形成し、発光層 した。この結果、角度分布補正後の外部量子効率は7% 50 とした。さらに、ホールブロック層としてTPBI層を

20nm、電子輸送層としてAlq,を30nm堆積した。この上に、LiFを0.5nm、Alを150nm 蒸着し金属電極を形成した。

【0093】以上のようにして形成された素子を、高真空排気したチャンバーに入れ、チャンバー内を1気圧の窒素で置換した後、紫外線硬化樹脂を用いて封止ガラスの端部を透明電極の表面に密着し密封した。このように形成された有機電界発光素子に直流電圧を印加し、連続駆動させて発光効率を測定した。

【0094】図20には、ホスト材料として、前述した 10 (a3)の物質のうち、フェニル基の数が1個(2,2 ービス(4-(N-カルバゾリル)フェニル)アダマンタン、AdPCz)と2個(2,2-ビス(4-(4'-(N-カルバゾリル)ビフェニル)アダマンタン、AdBPCz)の物質を使用した場合の電流密度と外部量子効率との関係が示される。図20に示されるように、AdBPCzを使用して室温で測定した場合、外部量子効率は最大で8%に到達した。また、ホスト材料として、AdPCzを使用し、他の材料は同様に使用して作製した有機電界発光素子の外部量子効率は最大で6%に 20 到達した。

【0095】図21には、上記AdBPCzを使用した有機電界発光素子について、室温及び85℃の雰囲気下での測定結果が示される。図21から分かるように、ホスト材料に耐熱性があるため、85℃雰囲気下に3時間放置した後、その雰囲気下で外部量子効率を測定しても、室温測定での外部量子効率とほとんど変わらなかった。ホスト材料をCBPにした場合は85℃で外部量子効率の大きな低下があることを考慮に入れると、2,2ービス(4-(4'-(N-カルバソリル)ビフェニル)アダマンタンは耐熱性の点で優れていることが分かる。

【0096】上記2, 2-ピス(4-(N-カルパゾリル)フェニル)アダマンタン(<math>AdPCz)は、以下の手順により合成できる。

【0097】2,2-(4-ヨードフェニル) アダマンタンを1.0g(1.85ミリモル)、カルバゾールを3.10g(18.5ミリモル)、K,CO,を2.6g(18.8ミリモル)、銅粉を2.3g(36.2ミリモル)、CuBrを0.8g(5.58ミリモル)、デ40カリンを15g混合し、窒素雰囲気下、170~180℃で20時間攪拌した。反応溶液を冷却後、CHC1,を50ml添加し、濾過した。この濾液を濃縮し、残さをシリカゲルカラム(CHC1,:ヘキサン=1:2)で精製した。得られた固体をCHC1,から再結晶し、2、2-ビス(4-(N-カルバゾリル)フェニル)アダマンタンを淡黄色粉末として176.5mg得た。【0098】この材料の構造を、赤外分光光度計(IR)及び核磁気共鳴(NMR)により確認した。IR及びNMRのデータを以下に示す。50

【0099】 IR(KBr): 3040, 2900, 2850, 1620, 1600, 1510, 1450, 1330, 1310, 1225, 745, 720 cm^{-1} NMR(CDC1,): 8.13(d,4H), 7.71(d,4H), 7.51(d,4H), 7.40(t,4H), 7.27(t,4H), 3.42(s,2H), 2.20 (d,4H), 1.88(dd, 8H) CO2, 2-UZ, $(4-(N-\pi)\text{N}\text{V}\text{V}\text{V}\text{V})$ フェニ

ル) アダマンタンの構造式は以下の通りである。

[0100]

【化26】

また、上記2, 2-ピス(4-(4'-(N-カルバゾリル)) ピフェニル) アダマンタン(<math>AdBPCz)は、以下の手順(1)、(2) により合成できる。

【0101】(1)4-(N-カルバゾリル)フェニル ホウ酸の合成

N- (4-ヨードフェニル) カルバゾール2.0g (5. 42 ミリモル)をTHF 15m1とジエチルエー テル5m1の混合溶媒に添加し、窒素雰囲気下、-90 ℃以下に冷却した。この溶液に 1.5M n-BuLi 溶液 (n-ヘキサン) 3.8ml (5.7ミリモル)を 滴下した。次に、-90℃以下で20分間攪拌し、トリ 30 メトキシボラン 0. 6 1 m 1 (5. 4 4 ミリモル) をゆ っくり滴下した。-90℃以下で20分間攪拌後、室温 で1時間攪拌した。その後、水3m1を添加し、2N NaOH水溶液20mlを加えて水層を分離した。さら に、有機層を2N NaOH水溶液20mlで2回抽出 し、水層を合わせた。1N H,SO,水溶液で中性に し、析出した沈殿を濾過し、水洗した。この沈殿をCH Cl,75mlに溶解し、Na,SO,で乾燥後、溶液を **濃縮した。沈殿をトルエン50mlから再結晶し、4-**(N-カルパゾリル) フェニルホウ酸を白色粉末として 1.07g得た。

【0102】との材料の構造を、赤外分光光度計(IR)及び核磁気共鳴(NMR)により確認した。IR及びNMRのデータを以下に示す。

[O 1 O 3] IR (KBr) : 3380, 3280, 3060, 1605, 145 0, 1410, 1375, 1345, 1330, 1305,1220, 1170, 745, 7 20, 690cm⁻¹

NMR(CDC1,): 8.33(S,2H), 8.31(d,2H), 8.15(d,2H), 7.66(d,2H), 7.50(t,2H), 7.48(d,2H), 7.36(t,2H) この4-(N-カルバゾリル) フェニルホウ酸の構造式 50 は以下の通りである。

10

[0104] 【化27】

49

(2) 2, 2-ビス(4-(4'-(N-カルパゾリ ル) ピフェニル) アダマンタンの合成 4-(N-カルパゾリル)フェニルホウ酸を1.0g (3.48ミリモル)、2,2-ビス(4-ヨードフェ ニル) アダマンタンを627mg(1.16ミリモ ル)、Pd (OAc) 2を26mg (0.116ミリモ ル)、トリ(o-トルイル)ホスフィンを106mg (0.348ミリモル)、Na,CO,を558mg $(5.26 \le y \le w)$ 、1,2-ジメトキシエタンを1 1 m 1、水を2 m 1 混合し、窒素雰囲気下、100℃で 15時間攪拌した。反応溶液を冷却後、水15m1を加 え、CHC1,で抽出した。CHC1,層を飽和食塩水で*20

*洗浄後、Na,SO,で乾燥し、溶液を濃縮した。残さを シリカゲルカラム (CHC1,: ヘキサン=1:4~ 1:3) で精製し、2,2-ビス(4-(4'-(N-カルバゾリル) ピフェニル) アダマンタンを淡黄色粉末 として234.4mg得た。

【0105】この材料の構造を、赤外分光光度計(1 R)及び核磁気共鳴(NMR)により確認した。IR及 びNMRのデータを以下に示す。

[0 1 0 6] IR(KBr): 3050, 2905, 2860, 1620, 1600, 1520, 1500, 1480, 1455, 1370, 1335, 1315, 1230, 8 10, 750, 720cm⁻¹

 $NMR(CDCl_1): 8.15(d,4H), 7.77(d,4H), 7.61(s,8H), 7.$ 59(d,4H), 7.47-7.40(m,8H), 7.29(t,4H), 3.39(s,2H), 2.16(d,4H), 1.91-1.79(m,8H)

 $CO2, 2-U2, (4-(4'-(N-\pi)N'))$ ビフェニル) アダマンタンの構造式は以下の通りであ

[0107] 【化28】

実施例8. ガラス基板上にITOの透明電極を150n m形成し、その上に真空度 $5 \times 10 - 7$ トールで $\alpha - N$ PDを40nm真空蒸着して正孔輸送層を形成した。そ の上にホスト材料としてガラス転移温度(Tg)が17 2°Cの1、3、5 - トリス [4 - (N - カルバゾリル) フェニル] ベンゼン (TCPB、前述した(a4)の 物質)を使用し、これにドーパントとしてIr(pp y) , を7 w t %の濃度でドープした層を20nm形成 し、発光層とした。さらに、ホールブロック層としてT 40 PBI層を20nm、電子輸送層としてAlq,を30 nm堆積した。との上に、LiFを0.5nm、Alを 150nm蒸着し金属電極を形成した。

【0108】以上のようにして形成された素子を1×1 0-6 トールに排気した真空チャンバーへ入れ、チャン バー内を1気圧の窒素で置換した後、紫外線硬化樹脂を 用いて封止ガラスの端部を透明電極の表面に密着し密封 した。

【0109】 このように形成された有機電界発光素子に 直流電圧を印加し、連続駆動させて発光効率を測定し

た。外部量子効率は最大で12%であった。また、初期 輝度1500cd/m'の場合、この素子の輝度半減寿 命が300時間であった。この結果はCBPをホスト材 料として利用した場合より長い。さらに、初期輝度15 00cd/m²、85℃の雰囲気で輝度半減寿命は25 0時間であった。CBPを利用した場合の85℃雰囲気 下における輝度半減寿命は室温における輝度半減寿命の 半分以下になるものと比較すると高温での耐久性が高い ととが示された。

[0110]

【発明の効果】以上説明したように、本発明によれば、 ホール輸送層または電子輸送層のいずれかに燐光発光分 子をドープした発光層を有し、このホール輸送層または 電子輸送層を構成するホスト材料が、燐光発光分子のス ベクトルと重なりが存在するスペクトルを有する燐光を 発生する性質を有し、かつ100℃以上のガラス転移温 度を有するので、高い燐光発光効率を有し、かつ高い耐 熱性を有する有機電界発光素子を得ることができる。

50 【図面の簡単な説明】

52

【図1】 イリジウム錯体の燐光発光分子をドーパントとした場合の燐光発生のメカニズムの説明図である。

【図2】 本発明に係る有機電界発光素子の実施形態1 の断面図である。

【図3】 図2に示された有機電界発光索子のエネルギー準位図である。

【図4】 本発明に係る有機電界発光素子の実施形態1 の変形例の断面図である。

【図5】 図4 に示された有機電界発光素子のエネルギー準位図である。

【図6】 本発明に係る有機電界発光素子の実施形態2 の構成の断面図である。

【図7】 図6に示された有機電界発光素子のエネルギー準位図である。

【図8】 本発明に係る有機電界発光素子の実施形態2 の変形例の構成の断面図である。

【図9】 図8 に示された有機電界発光素子のエネルギー準位図である。

【図10】 図4に対応する有機電界発光素子の具体的な実施例の断面図である。

【図11】 図4に対応する有機電界発光素子の具体的な実施例の断面図である。

【図12】 図10及び図11に対する比較例の構成の 断面図である。 ** *【図13】 図10及び図12に示された有機電界発光 素子の電流密度対外部量子効率を示す図である。

【図14】 図11及び図12に示された有機電界発光 素子の電流密度対外部量子効率を示す図である。

【図15】 図11及び図12に示された有機電界発光 素子の素子温度対外部量子効率の変化を示す図である。

【図16】 図6に示された実施形態2に対応する具体的な実施例を示す図である。

【図17】 有機薄膜の耐熱性を比較するための薄膜構 10 造を示す図である。

【図18】 図17(a)、(b)の薄膜の耐熱試験の 結果を示す図である。

【図19】 図17 (c)の薄膜の耐熱試験の結果を示す図である。

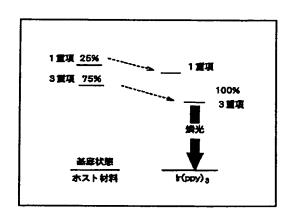
【図20】 実施例7にかかる有機電界発光素子の電流 密度と外部量子効率との関係を示す図である。

【図21】 実施例7にかかる有機電界発光素子の室温 及び85℃の雰囲気下での電流密度と外部量子効率との 関係を示す図である。

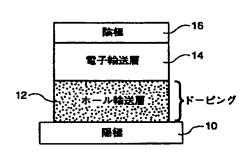
20 【符号の説明】

10 陽極、12 ホール輸送層、14 電子輸送層、 16 陰極、18 第2のホール輸送層、20 第2の 電子輸送層。

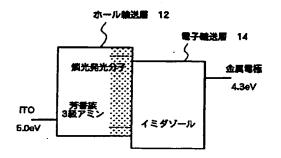
【図1】



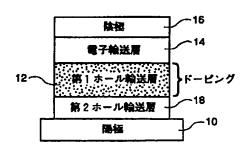
【図2】

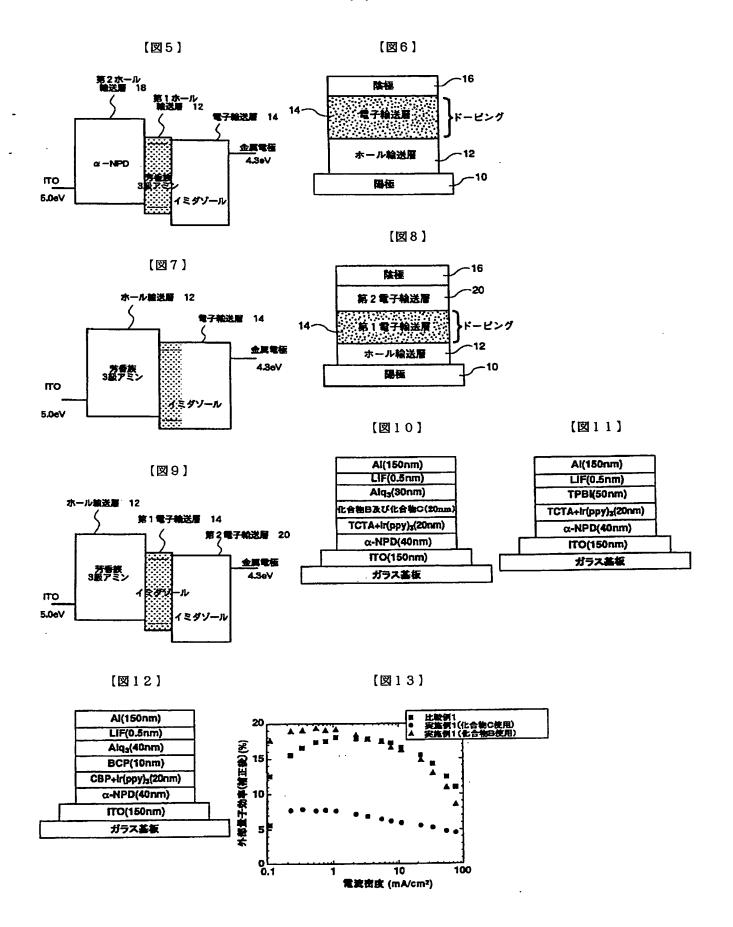


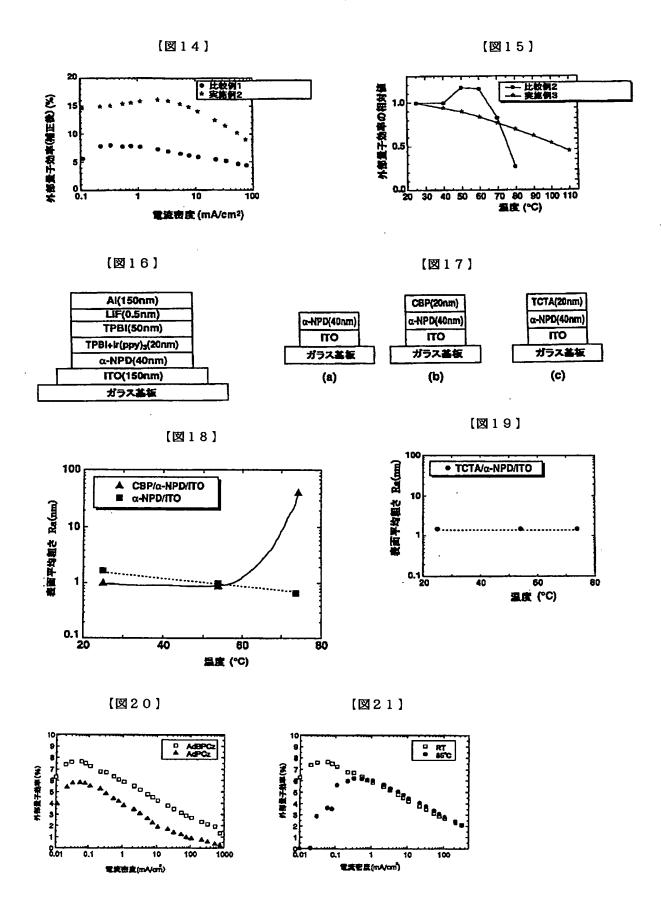
[図3]



[図4]







フロントページの続き

(72)発明者 時任 静士

愛知県愛知郡長久手町大字長湫字横道41番 地の1 株式会社豊田中央研究所内 (72)発明者 多賀 康訓

愛知県愛知郡長久手町大字長湫字横道41番 地の1 株式会社豊田中央研究所内 Fターム(参考) 3K007 AB02 AB03 AB11 CA01 CB01 DA01 DB03 EB00

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

□ BLACK BORDERS
□ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
□ FADED TEXT OR DRAWING
□ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
□ SKEWED/SLANTED IMAGES
□ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
□ GRAY SCALE DOCUMENTS
□ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
□ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

□ OTHER:

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.